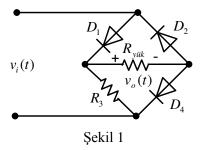
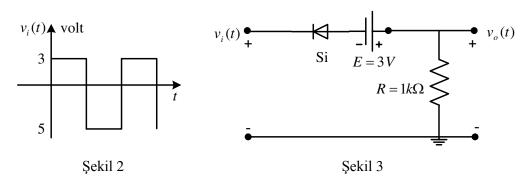
## Elektronik Devreleri ve Laboratuvarı Vize Sınavı

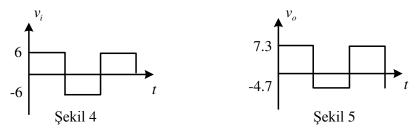
- **1.** Şekil 1.'deki devrenin girişine  $v_i(t) = 6\sin \omega t$  işareti uygulandığında;
- a) Yük direnci üzerindeki  $v_o(t)$  geriliminin dalga şeklini tepe değerlerini göstererek çiziniz.
- b) Yük üzerindeki doğru gerilimi hesaplayınız ( $R_{viik} = 6 k\Omega$ ,  $R_3 = 2 k\Omega$ ) (**Diyot idealdir**).
- c) Diyotlar üzerindeki PIV değerlerini bulunuz.



2. Şekil 2.'deki gibi bir işaret şekil 3.'deki kırpıcı devrenin girişine uygulandığında çıkıştaki  $v_o(t)$  geriliminin dalga şeklini veriniz (**Diyot silisyumdur**).



3. Girişine şekil 4.'deki gibi  $f = 1 \, kHz$ 'lik bir  $v_i$  gerilim işareti uygulandığında, çıkışında şekil 5.'deki gibi bir  $v_o$  gerilim işareti elde edebileceğimiz bir kenetleme devresi tasarlayınız. Tasarlamış olduğunuz devredeki elemanlara değer tayin ederek devrenin çalışmasını açıklayınız. Devrede kullanılan **diyotun silisyum** olduğu kabul edilecektir.



**4.**  $1.5 \, k\Omega$ 'luk bir yük direnci üzerinde 15 voltluk bir çıkış gerilimi sağlayacak, 25 ila 45 volt arası girişe sahip bir gerilim regülatörü tasarlayınız. Yani uygun  $R_s$  değerini ve maksimum zener akımı  $I_{Z_{\rm max}}$  değerini bulunuz.

## Süre 90 dakikadır. Kitap ve notlar kapalıdır. Başarılar.

1a.

0-T/2 aralığında D1 ve D4 iletimde, D2 diyotu ise tıkamadadır.

$$R_{esd} = \frac{R_{yiik} \times R}{R_{yiik} + R_3} = \frac{6 \times 2}{6 + 2} = 1.5 \, k\Omega$$

$$I = \frac{V_i}{R_{esd}} = \frac{6V}{1.5 \, k\Omega} = 4 \, mA$$

$$I_{yiik} = \frac{V_o}{R_{yiik}} = \frac{6V}{6 \, k\Omega} = 1 \, mA$$

$$I_{R3} = \frac{V_o}{R_3} = \frac{6V}{2 \, k\Omega} = 3 \, mA$$

$$V_o = R_{yiik} I = 6 \times 1 = 6V$$

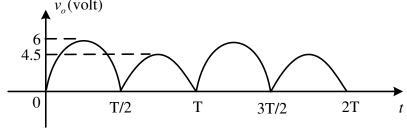
T/2-T aralığında D1 ve D4 tıkamada, D2 diyotu ise iletimdedir.

$$R_{esd} = R_{yiik} + R_3 = 6 + 2 = 8 k\Omega$$

$$I = \frac{V_i}{R_{esd}} = \frac{6 V}{8 k\Omega} = \frac{3}{4} mA$$

$$V_3 = R_3 I = 2 \times \frac{3}{4} = 1.5 V$$

$$V_o = R_{yiik} I = 6 \times \frac{3}{4} = 4.5 V$$



1h

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{0}^{\pi} 6\sin\omega t \, d(\omega t) - \int_{\pi}^{2\pi} 4.5\sin\omega t \, d(\omega t) \right] = -\frac{6}{2\pi} \cos\omega t \Big|_{0}^{\pi} + \frac{4.5}{2\pi} \cos\omega t \Big|_{\pi}^{2\pi}$$
$$= -\frac{6}{2\pi} (-1 - 1) + \frac{4.5}{2\pi} (1 + 1) = \frac{6}{\pi} + \frac{4.5}{\pi} = \frac{10.5}{\pi} \text{ Volt} = 3.34 \text{ Volt}$$

1c

$$PIV_{D1} = 4.5 V$$
  $PIV_{D2} = 6 V$   $PIV_{D4} = 6 V$ 

**2.** 0-T/2 aralığında diyot -6 volt ile tıkamadadır. O nedenle devreden akım geçmez ve çıkışta 0 volt görürüz.

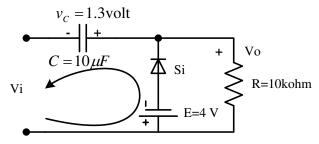
T/2-T aralığında diyot 1.3 volt ile iletimdedir. Bu nedenle çıkışta -1.3 volt görürüz.

$$v_o(t)$$
 volt
$$0$$
-1.3
$$T/2 \quad T \quad 3T/2$$

3. 0-T/2 aralığında diyot tıkamadadır. O nedenle analize T/2-T aralığından başlayacağız.

T/2-T aralığında giriş gerilimi  $V_i$ =-6 Volt, dc gerilim kaynağı -4 Volt ve silisyum diyot üzerinde düşen gerilim 0.7 volt olduğundan diyot 1.3 Volt ile iletimde olup kapasite  $V_c$ =1.3 Volt ile dolar ve çıkış gerilimi  $V_o$ =-4.7 Volt olur.

T-3T/2 aralığında C=10 mikroFarad lık kapasite, üzerindeki yükü R=10 kohm luk direnç üzerinden boşaltmak isteyecek ama boşalmaya zaman bulamayacak. Ve bu aralıkta çıkış gerilimi, kapasite üzerindeki 1.3 Voltluk gerilim ile 7.3 Voltluk giriş geriliminin toplamı olan  $V_o=1.3+6=7.3$  Volt olacaktır.



4.

$$I_{RL} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{15V}{1.5k\Omega} = 10mA$$

 $V_i \le V_{i \min}$  iken  $I_{RL} = I_{RS} = 10mA$  dir. O halde;

$$\begin{split} R_S &= \frac{V_{i\min} - V_Z}{I_{RS}} = \frac{V_{RS}}{I_{RS}} = \frac{(25-15)V}{10mA} = 1k\Omega = 1000\Omega \\ V_{i\max} &= I_{RS\max} R_S + V_Z \quad \Rightarrow \quad I_{RS\max} = \frac{V_{i\max} - V_Z}{R_S} \quad \Rightarrow \quad I_{RS\max} = \frac{(45-15)V}{1k\Omega} = \frac{30V}{1k\Omega} = 30mA \\ I_{RS\max} &= I_{Z\max} + I_{RL} \quad \Rightarrow \quad I_{Z\max} = I_{RS\max} - I_{RL} \quad \Rightarrow \quad I_{Z\max} = 30 - 10 = 20mA \end{split}$$